

卷頭言	幹事長就任にあたって 重川秀実（筑波大学・物理工）	1
研究	ナノエレクトロニクスに向けた技術展開 —その場・動作状態でのデバイス計測評価技術を中心にして—	
	VLSI 技術の進展と動作状態解析の重要性	3
	動作中 FET のキャリア分布計測	13
	電子線ホログラフィーによるデバイスの電界分布計測	19
談話室	東京理科大学 本間研究室	26
掲示板		
	研究会概要報告	
	・ 第 34 回 薄膜・表面物理セミナー (2006)	28
	・ 第 12 回 LSI 配線における原子輸送・応力問題研究会	30
開催案内		
	・ 第 35 回 薄膜・表面物理基礎講座	31
	・ The 5th International Conference on LEEM/PEEM (LEEM_PEEM-V)	32
	・ 2006 International Workshop on Dielectric Thin Films for Future ULSI Devices – Science and Technology – (IWDTF-06)	33
	・ 走査型プローブ顕微鏡 (20) (ICSPM14)	35
	・ 第 7 回 「イオンビームによる表面界面解析」特別研究会	36
	・ 「表面・ナノ科学シンポジウム 2007」(SSNS' 07)	37
	・ 第 12 回 ゲートスタッック研究会	39
	・ 9th International Conference on Atomically Controlled Surfaces, Interfaces and Nanostructures (ACSN-9)	40
薄膜・表面物理分科会 第 36・37 期幹事候補者募集		42
議事録		
	第 34 期第 6 回 常任幹事会議事抄録	43
	第 34 期第 5 回 幹事会議事抄録	45
	第 34 期第 6 回／第 35 期第 1 回 幹事会議事抄録	46
	第 35 期第 1 回 常任幹事会議事抄録	48
	第 35 期第 2 回 常任幹事会議事抄録	50
会 告	ニュースレター投稿規定	52
	応用物理学会 薄膜・表面物理分科会 第 35 期常任幹事名簿	53
	応用物理学会 薄膜・表面物理分科会 会員数、賛助会社名簿	54
編集後記		55

表紙写真 : p-n 接合近辺の電場 (a)ホログラム, (b)位相分布像
(平山司氏, 佐々木勝寛氏提供, 詳しくは本誌 23 ページ参照)